
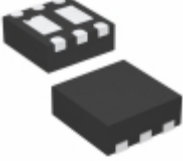

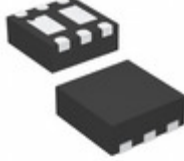
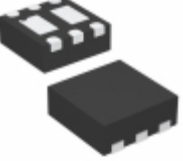
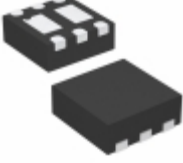


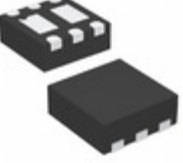
	<h2>SIB911DK-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIB911DK-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIB911DK-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 163095 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIB911DK-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	163095 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 2.6A 3.1W
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	3.1W
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Dual
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Dual
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	295 mOhm @ 1.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	115pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SIB911
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIB911DK-T1-GE3TR

SIB911DK-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIB911DK-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIB911DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIB911DK-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIB912DK-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 1.5A SC-75-6</p>	 <p><b>SIB911DK-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6</p>	 <p><b>SIB914DK-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 8V 1.5A PPAK SC75-6</p>	 <p><b>SIB900EDK-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 1.5A SC-75-6</p>
 <p><b>SIB914DK-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 8V 1.5A PPAK SC75-6</p>	 <p><b>SIBA 10.NH000</b> IGBT Module IGBT Modules</p>	 <p><b>SIB911DK-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6</p>	 <p><b>SIB912DK-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 1.5A SC-75-6</p>

### heiße Teile

Mehr

08052A151JAT2A	1206ZC683KAT2A	AD8014ARTZ-REEL7	D AD827JR-16-REEL	AD8293G80ARJZ-RL
ADA4310-1ACPZ-RL	ADM1818-5ARTZ-REEL7	D BF2012-L3R6DAAT/LF	BM1117-5.0	BYT230PIV400
C1005X5R1E154M050BC	CBS3504832-T	CGB3B1X7R1A105M055AC	CS61584A-IQ3Z	CSD16408Q5
D CSTCE15M5V53-RO	DD46S12K-K	GQM1555C2D3R0BB01D	LMV393L-SM1-T	LT1369CS#TRPBF
LTC2854CDD#TRPBF	MC74AC74MELG	MCR50JZH73R2	MIC59300WU-TR	NCP4300ADR2G
NJM3404AMR-TE1	PD55F160	D R7000405UA	RB088BM-40TL	RCLAMP0502A.TCT
SIB414DK-T1-GE3	D SIB414DK-T1-GE3	SIB422EDK-T1-GE3	SIB422EDK-T1-GE3	SIB437EDKT-T1-GE3
SIB437EDKT-T1-GE3	SIB900EDK-T1-GE3	SIB900EDK-T1-GE3	SIB911DK-T1-GE3	SIBA 10.NH000
SL5500SD	SLF1255T-101M1R1-PF	SPA11N60CFD	D TAR5SB33	TD170N400KOF
TS954IDT	UCC2895PWTR	VE-252-CU	XAA117STR	XC61GC2502HR

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited